

36 ഘടനയ്ക്ക് transistor.

\* 36 ഘടനയ്ക്ക് transistor ജോഡ് പ്രതിരോധ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്.

\* n pn , pnp transistors ന്റെ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്.

→ ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്.

\* 36 ഘടനയ്ക്ക് transistors ശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്.

i/. n-channel ധനധാരണയ്ക്ക് transistor :-

→ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്.

ii/. p-channel ധനധാരണയ്ക്ക് transistor :-

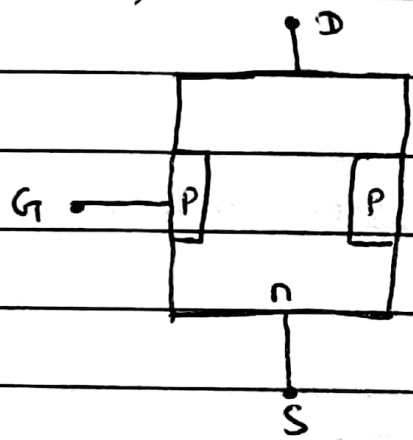
→ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതാണ്.



# \* 3D transistor VLSI (Very large Scale IC)

മൂന്നു മേഖലകളിലായി ~~മൂന്നു~~ മേഖലകളായി വരമ്പുകൾ കെട്ടി വെക്കുന്ന തരം.

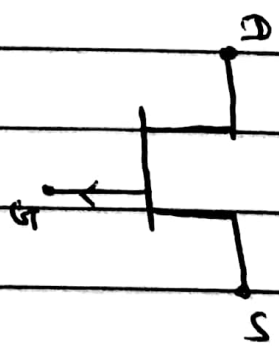
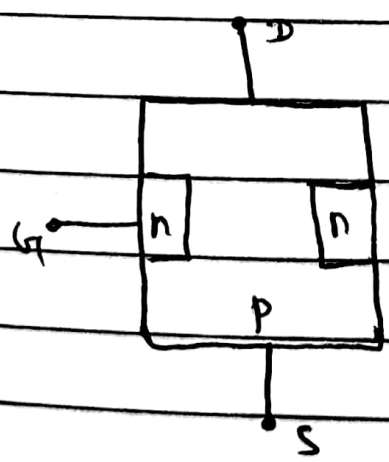
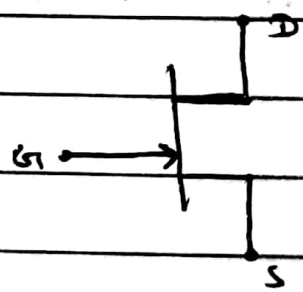
3D transistors മൂന്നു മേഖലകളിലായി കെട്ടി വെക്കുന്ന തരം.



D - Drain (മുഖ്യം)

G - Gate (കെട്ടി)

S - Source (മൂലം)



14

التاريخ

اليوم

عنوان الدرس

الموافق

Subject

Day

Date

Transistor (Common Emitter) Configuration

I. Introduction (CS)

Transistor is a semiconductor device used for amplification and switching.

Common Emitter (CE) Configuration

II. Characteristics (D)

Common Emitter (CE) Configuration is the most widely used configuration.

It provides high voltage gain and moderate current gain.

III. Advantages / Disadvantages (E)

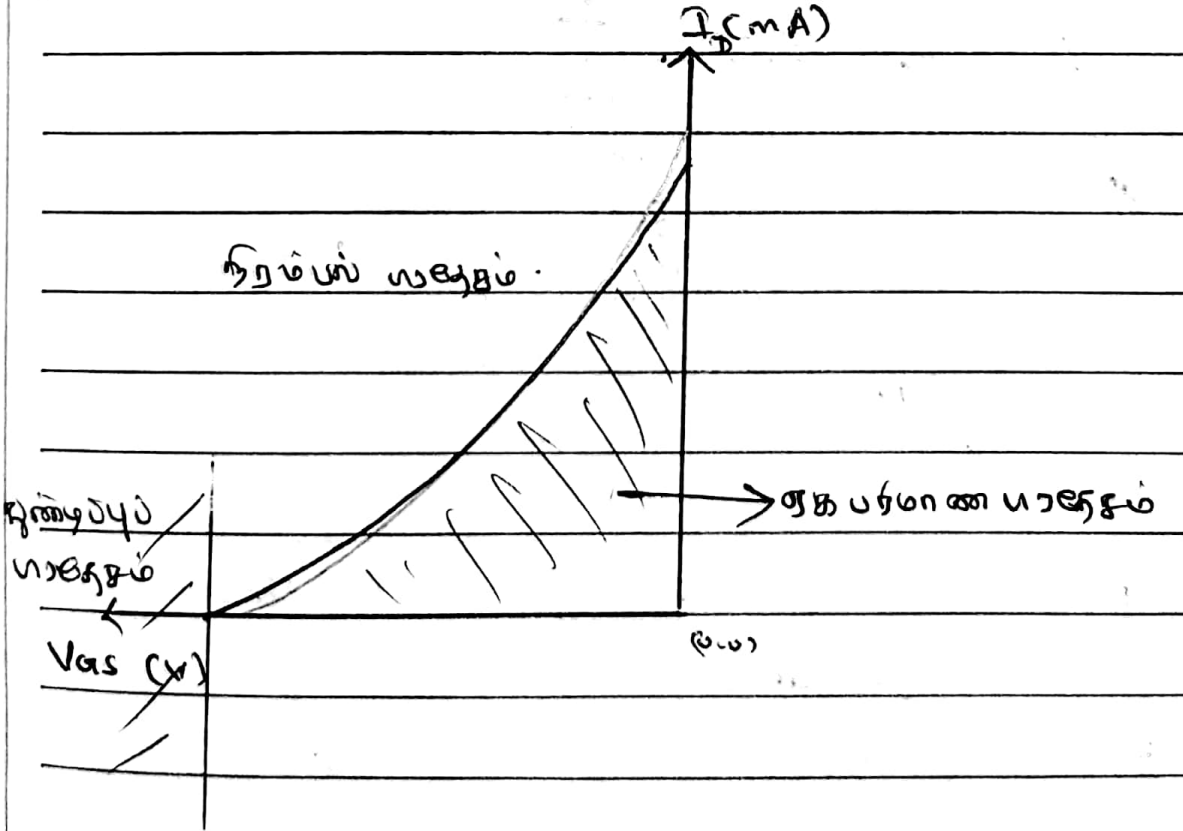
Advantages: High voltage gain, moderate current gain, phase inversion.



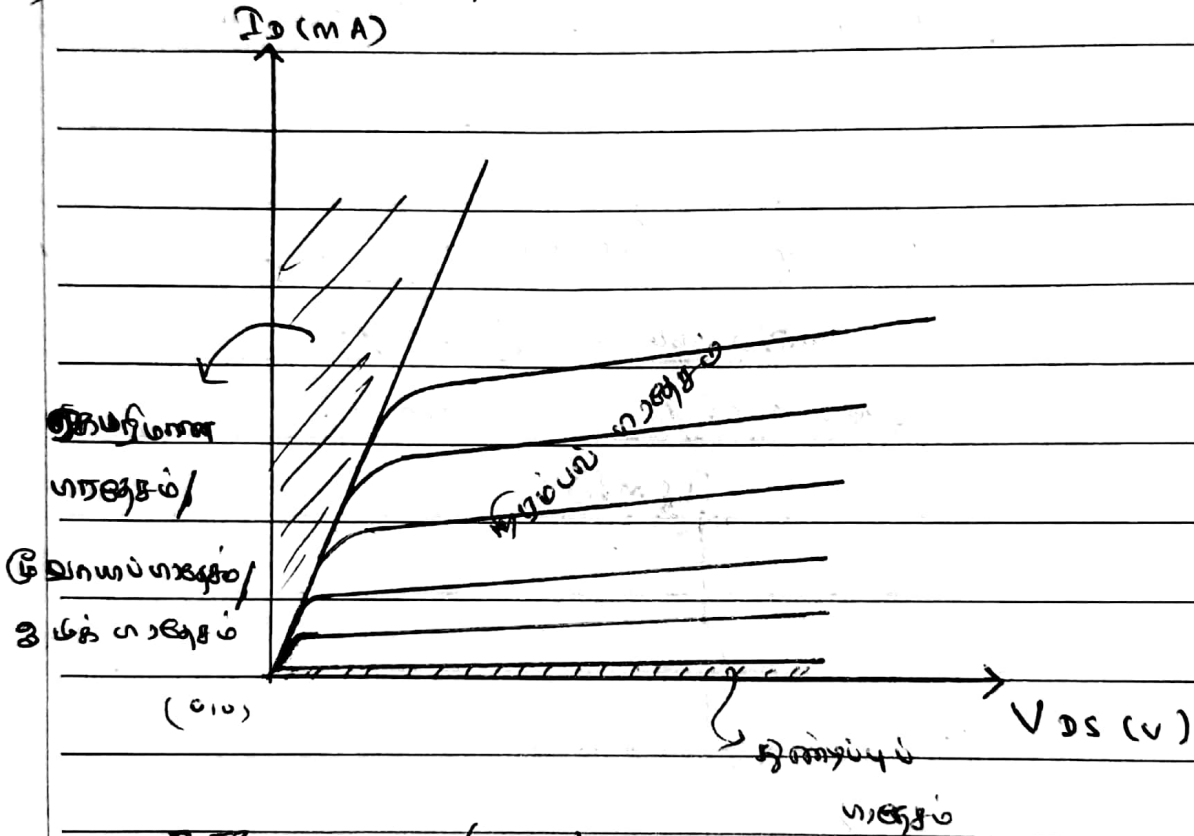


\* VGS മൂലമുള്ള  $I_D$  നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കുക  
 ഹെർഷെൽ നിയന്ത്രണം Di S കോമ്പോസിറ്റിംഗ് പ്രദേശം  
 ഉണ്ടാക്കുക.

\* n channel ഗവണ്മെന്റ് transistor ന്റെ പ്രവൃത്തി  
 ഉത്തരവ് നൽകുക വെർച്വൽ പ്രവൃത്തി  
 1. ഗവണ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ്.



II. Study thoroughly any.



BJT (FET) transistors ന്നും ഉപയോഗം.

\* I. BJT ഉപയോഗം ഉപയോഗം FET ഉപയോഗം ഉപയോഗം ഉപയോഗം ഉപയോഗം.

II. BJT ഉപയോഗം ഉപയോഗം FET ഉപയോഗം ഉപയോഗം ഉപയോഗം ഉപയോഗം.

III. ഉപയോഗം ഉപയോഗം BJT ഉപയോഗം ഉപയോഗം ഉപയോഗം ഉപയോഗം.



iv/ BJT சீரமைப்பு செயலாக்கத்தில் பல்பகுதிப்படுத்தல் -  
 சீரமைப்பு FET சீரமைப்பு அடுக்குகளில் பல்பகுதிப்படுத்தல் -

v/ FET & 2-பகுதிப்படுத்தல் மூலம் மிகவும் மென்மையான BJT &  
 2-பகுதிப்படுத்தல் மூலம் மிகவும் மென்மையான மூலம்.

தெரிவரைத் திண்பு சிற்றுவகை மும் தெரிவரைத் திண்பு சிற்றுவகை மும்.

\* திண்பு சிற்றுவகை மும் தெரிவரைத் திண்பு சிற்றுவகை மும்.

I. தெரிவரைத் திண்பு சிற்றுவகை மும்.

⇒ உய்ய திண்பு மட்டமார்த்து) திண்பு சிற்றுவகை மும்

உய்ய திண்பு மட்டமார்த்து மார்த்து திண்பு மட்டமார்த்து

அது தெரிவரைத் திண்பு சிற்றுவகை மும்.

⇒ தெரிவரைத் திண்பு சிற்றுவகை மும் (தெரிவரைத் திண்பு, உய்ய)

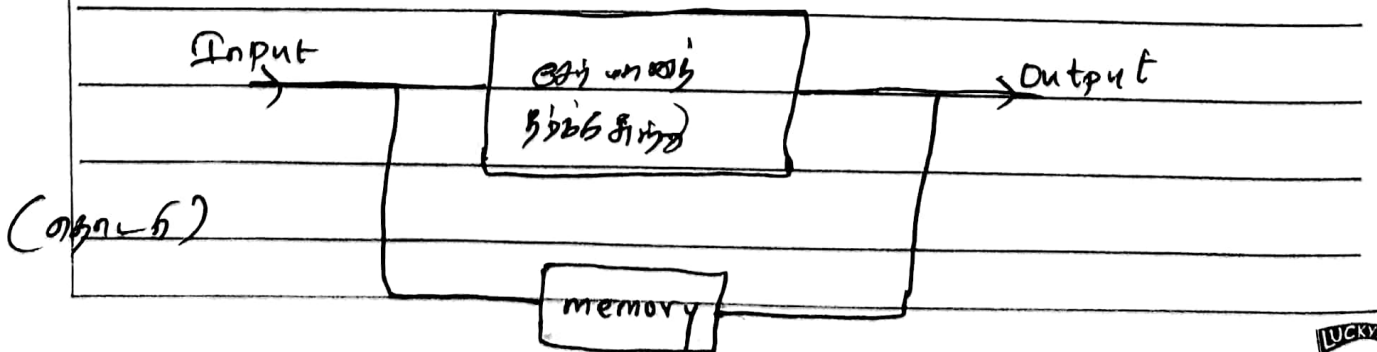
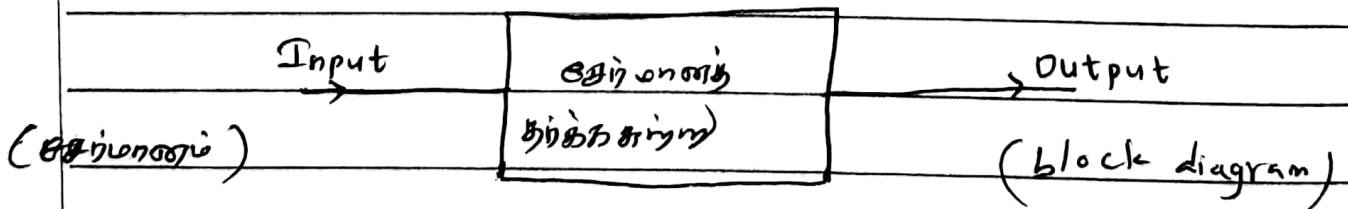
உய்ய தெரிவரைத் திண்பு சிற்றுவகை மும்.

II. தெரிவரைத் திண்பு சிற்றுவகை மும்

⇒ உய்ய திண்பு மட்டமார்த்து திண்பு சிற்றுவகை மும்

உய்ய, உய்ய மட்டமார்த்து திண்பு மட்டமார்த்து

அது தெரிவரைத் திண்பு சிற்றுவகை மும்.





\* பெரியவைகள் தர்ப்பெரியவைகள்

உதாரணம் :-

NOT Gate

AND Gate

OR Gate

NAND Gate . . . . . சிறியவைகள்

\* பெரியவைகள் தர்ப்பெரியவைகள்

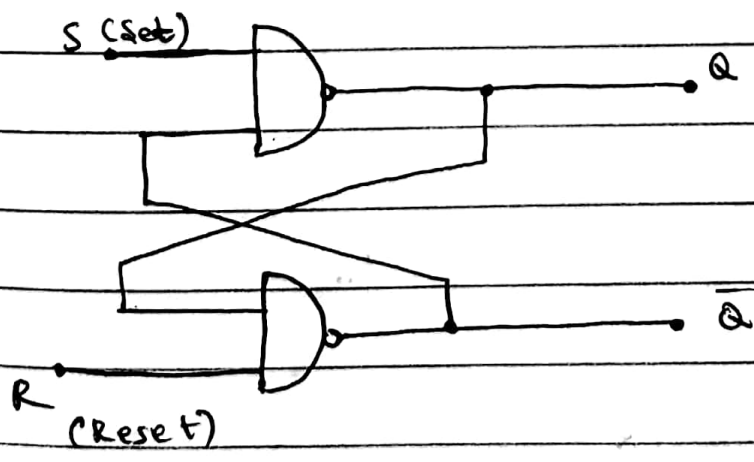
உதாரணம் :-

flip-flop ⇒

SR flip flop

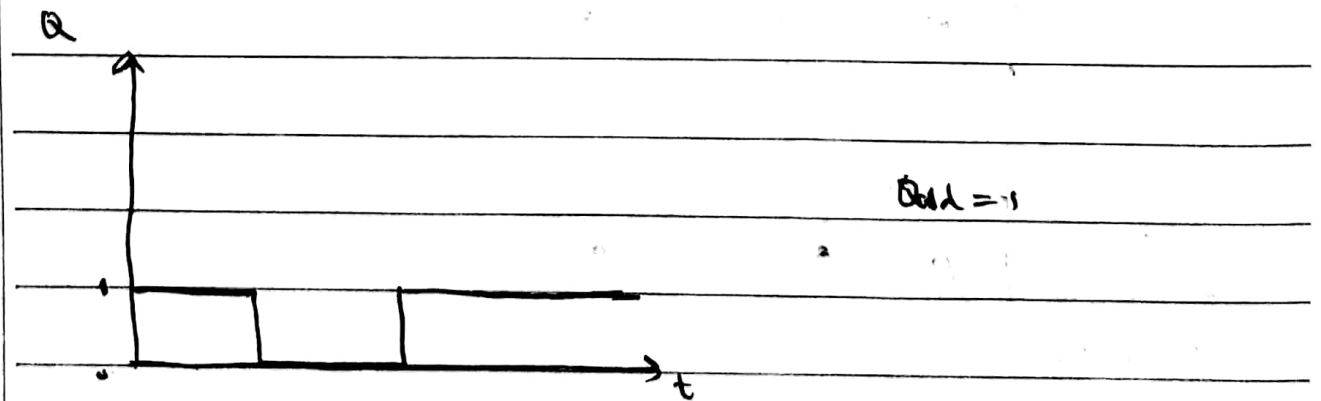
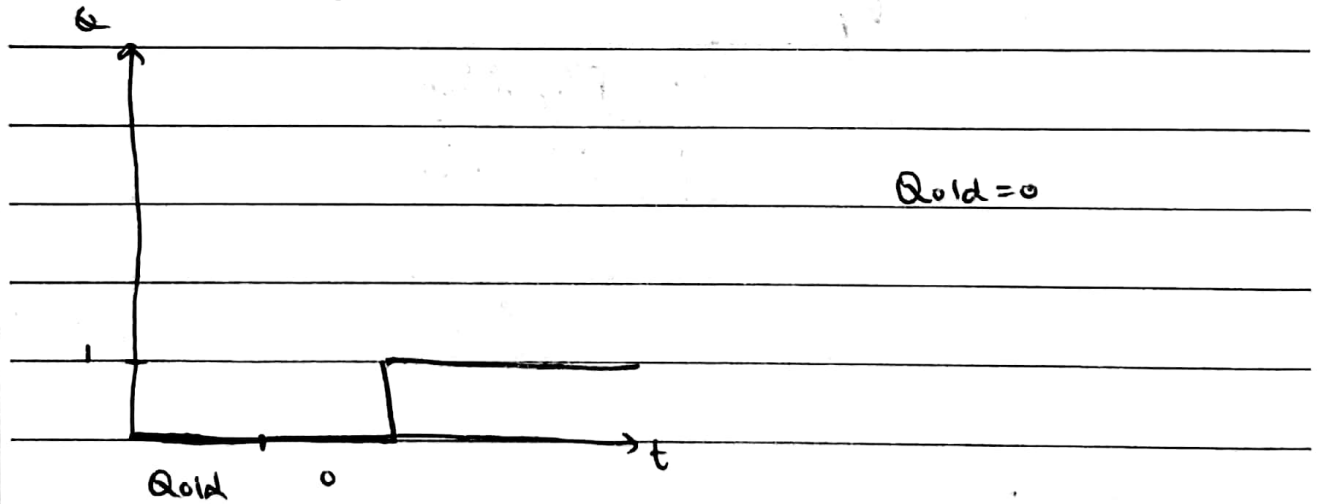
D flip flop

NAND Gate ஐப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் SR flip flop

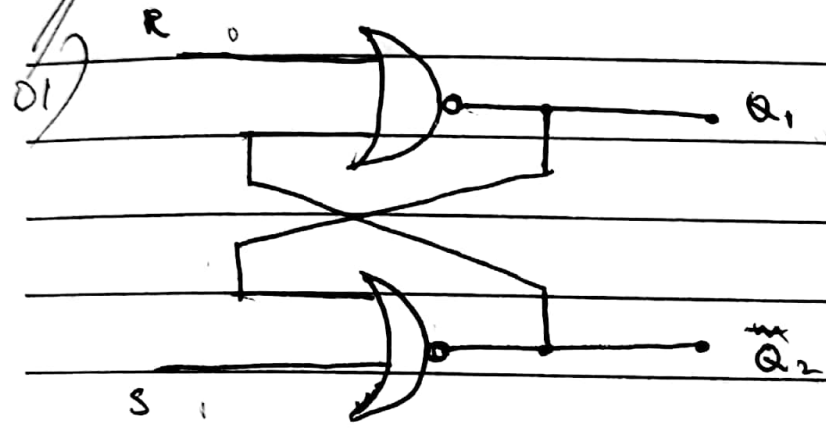


R	S	Q <sub>new</sub>
0	0	Q <sub>old</sub>
0	1	0
1	0	1
1	1	Not Applicable (سواء في الترميز)

Timing diagram (توقيت)



Ex/



S, R ക്രമം മാറ്റിയിട്ട് റിജിസ്റ്റർ  
 സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്ത Q1, Q2 ക്രമം 0, 1 ആയി  
 സാധ്യമാകും. ശല്യമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ക്രമം S, R ക്രമം ക്രമം 1, 0 ആയി  
 മാറ്റി ശല്യമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത Q1, Q2 ക്രമം  
 ക്രമം മാറ്റി ശല്യമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

S	R	Q1	Q2
0	0	0	1
1	0	1	0